$\mathrm{EE}531$ - Turma S

Diodos

 $Laborat\'orio\ de\ Eletr\^onica\ B\'asica\ I\ -\ Segundo\ Semestre\ de\ 2010$

Professor: José Cândido Silveira Santos Filho

DANIEL LINS MATTOS RA: 059915 RAQUEL MAYUMI KAWAMOTO RA: 086003 TIAGO CHEDRAOUI SILVA RA: 082941

10 de setembro de 2010

Para este experimento da disciplina de laboratório de eletrônica básica I, tem-se como objetivo caracterizar diodos semicondutores, familiarizar-se com seus principais parâmetros e realizar circuitos que os possuam. As ferramentas utilizadas são a fonte de alimentação dual, um gerador de funções e um osciloscópio digital. Para este presente experimento utilizam-se ainda um protoboard, dois resistores de $10k\Omega$, um resistor de $1k\Omega$ três capacitores eletrolíticos de de 100μ F, oito diodos 1000, dois diodos 1000, um amplificador operacional 1000, um tranformador de 11000, 10

Parte Experimental

1. Para esta parte inicial do experimento, o gerador de funções é ajustado para produzir um sinal de tensão com sua forma de onda triangular, com amplitude $10V_{pp}$, com offset de 5V, frequência de 10kHz e simetria de 50%.

Além disso, o circuito da figura 1 — composto de um amplificador operacional 741, um resistor (R_i) de $1k\Omega$, e dois diodos 1n4148 $(D_1$ e $D_2)$ — é montado e o canal um do osciloscópio é colocado entre D_1 e R_i e o canal dois na saída do amplificador operacional.

É importante que a onda gerada seja positiva, pois caso fosse negativa diodo D_1 atuaria bloquearia o sinal, logo o amplificador operacional saturaria.

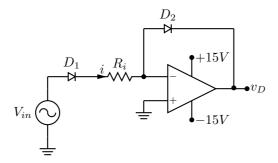


Figura 1: Circuito para caracterização V versus I do diodo

Supondo que o amplificador operacional seja ideal, nenhuma corrente de entrada é drenada, ou seja, a corrente i caracterizada em D_1 e R_i é a mesma que em D_2 . Além disso, a tensão entre o terminal de saída e o terra é equivalente a $A(v_2 - v_1)$, sendo o ganho A idealmente infinito. Logo, tem-se que:

$$\frac{V_D}{A} = (v_2 - v_1) \approx 0 \tag{1}$$

Como $v_1 = 0$ temos que $v_2 = 0$, assim:

$$i = \frac{V_{CH2}}{R_i} \tag{2}$$

Utilizando o canal 1, tem-se que:

$$V_D = -V_{CH1} \tag{3}$$

Utilizando o recurso Time Base X-Y do osciloscópio, obtemos uma curva caracterísica (V versus I) do diodo presente na figura 2. As escala do eixo V_D vale 500mV/c'elula. Portanto, o diodo em condução direta apresenta um queda de tensão de aproximadamente 0,7V.

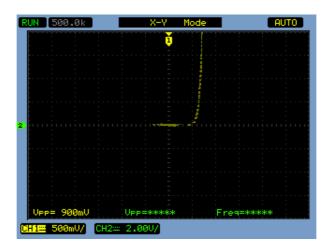


Figura 2: Curva característica V versus I do diodo



Figura 3: Curva de histerese

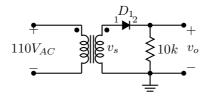


Figura 4: Circuito retificador de meia onda

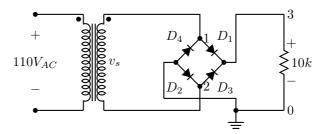


Figura 5: Circuito retificador de onda completa

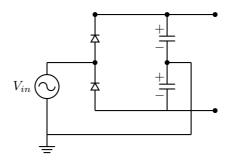


Figura 6: Duplicador de tensão

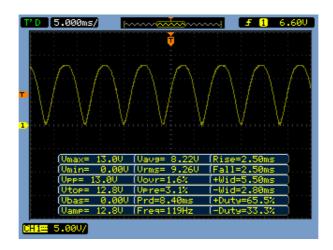


Figura 7: Medida da tensão no nó $3\,$

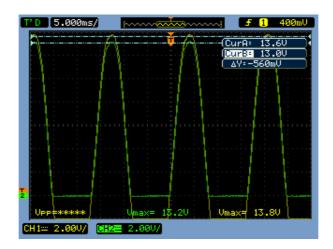


Figura 8: Medida da tensão diferencial entre os nós 2 e 3

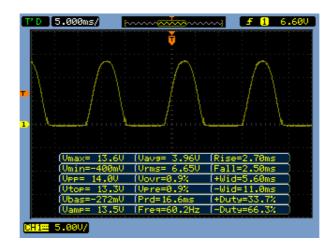


Figura 9: Medida da tensão no nó 1

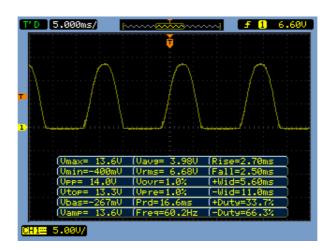


Figura 10: Medida da tensão no nó $2\,$

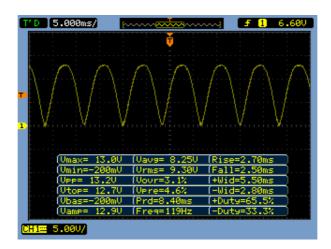


Figura 11: Medida da tensão diferencial entre os nós 2 e 3

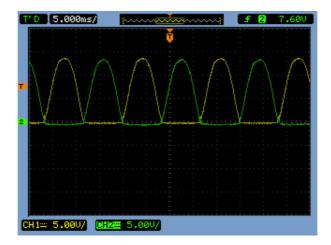


Figura 12: Medida da tensão nos nós 1 e 2

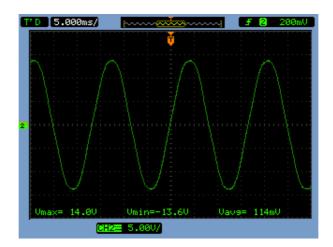


Figura 13: Medida da tensão diferencial entre os nós 2 e 3

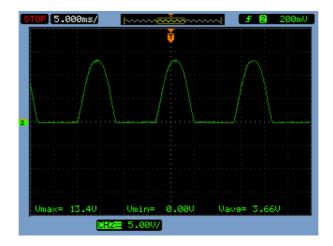


Figura 14: Medida da tensão diferencial entre os nós 2 e 3

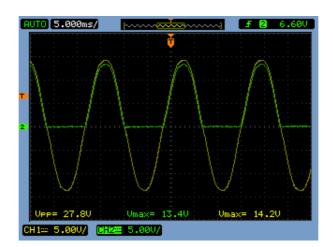


Figura 15: Medida da tensão diferencial entre os nós 2 e 3



Figura 16: Medida da tensão diferencial entre os nós 2 e 3



Figura 17: Tensão de saída nos nós 1 e 2

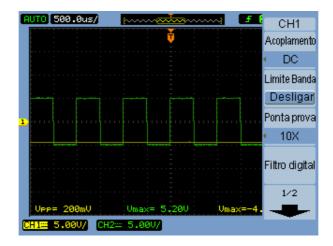


Figura 18: Análise do sinal de saída no nó $\mathbf x$

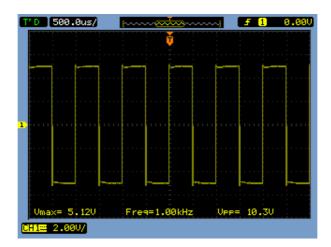


Figura 19: Onda de entrada do circuito

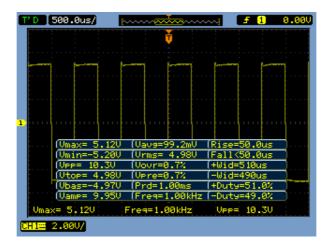


Figura 20: Medidas da onda de entrada do circuito



Figura 21: Característica onda após a inserção de capacitor em paralelo

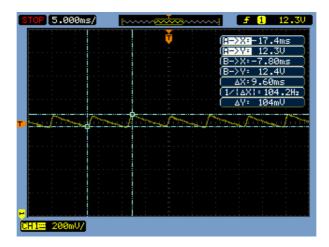


Figura 22: Aproximação da imagem da onda após a inserção de capacitor em paralelo